

沿革・業績

昭和23年度～昭和50年度

昭和23年度（1948年）

- ・「電気通信研究所発足」

昭和25年度（1950年）

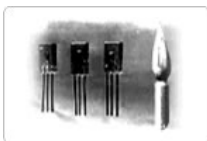
- ・Ge点接触トランジスタ試作

昭和27年度（1952年）

- ・「日本電信電話公社発足」

昭和28年度（1953年）

- ・Ge接合型トランジスタ試作



昭和30年度（1955年）

- ・「半導体研究室設置」

昭和33年度（1958年）

- ・合金型Geトランジスタの高周波化 $f_{\alpha}=130\text{MHz}$



昭和35年度（1960年）

- ・「電気通信研究所茨城支所開設」



昭和38年度（1963年）

- ・Siメサトランジスタ試作（ $f_{\alpha}>600\text{MHz}$ ）

昭和40年度（1965年）

- ・ 論利用ICの研究開始
- ・ GaAs半導体部品の研究開始
- ・ 境界層磁気コンデンサ（BLコンデンサ）実用化



昭和41年度（1966年）

- ・ 「基礎研究部発足」

昭和43年度（1968年）

- ・ 非しきい値論理回路（NTL）の発案



昭和46年度（1971年）

- ・ 「集積回路研究部発足」
- ・ 「研究開発本部発足」
- ・ 「茨城電気通信研究所発足」

昭和48年度（1973年）

- ・ 段付電極構造トランジスタ（SET）の発案